PAT-NO:

JP411068004A

DOCUMENT-IDENTIFIER:

JP 11068004 A

TITLE:

SEMICONDUCTOR DEVICE AND METHOD OF MOUNTING

SEMICONDUCTOR DEVICE ON SUBSTRATE

PUBN-DATE: March 9, 1999

INVENTOR-INFORMATION:

NAME

HOSOKAWA, HIROAKI ASSIGNEE-INFORMATION:

NAME

COUNTRY

N/A

SONY CORP APPL-NO:

JP09223242

APPL-DATE:

August 20, 1997

INT-CL (IPC): H01L023/50, H01L023/28, H05K003/00, H05K003/34

ABSTRACT:

PROBLEM TO BE SOLVED: To improve the adhesion strength by irradiating the back side of a package for a surface mount type semiconductor device, having a

package sealed with a mold resin, with a laser beam.

SOLUTION: Font-selecting scanner mirrors 22a, 23A driven by galvanometers 24a, 25a to select characters marked on a font mask 28, the back side is irradiated with a laser beam to stamp marks, utilizing a package marking apparatus for transferring them on a work, thereby elevating the wettability and further irradiated with a laser beam to remove wax components. This improves the wettability of adhesives to the package and adhesion strength as well and hence avoids dropping a semiconductor device during processing and improves the adhesion strength, irrespective of the type of the adhesives.

COPYRIGHT: (C) 1999, JPO

(19)日本国特許庁(J P)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平11-68004

(43)公開日 平成11年(1999)3月9日

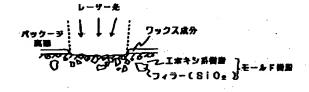
(51) Int.CL*	識別記号	PΙ				
H01L 23/50		HO1L 2	3/50	Z N		
23/28	504	2	3/28			
H05K 3/00		H05K	3/00			
3/34			3/34			
		客主請求	未請求	請求項の数 6	OL (全(3 頁)
(21)出順番号	特數平9-223242	(71)出廣人			9-	
(aa) iliitiit T	평균 6 분 / 1007\ 9 분 90 년			枝式会社 3.川区北品川 6 7	日7銀8号	
(22) 出顧日	平成9年(1997)8月20日	(72)発明者			i i i i i i i i i	
		(10)2011		別区北島川67	目7番35号	ソニ
		÷	71.043	4 tru 3 .		
		_				
				•		
•						
	•					•

(54) [発明の名称] 半導体装置および半導体装置の基板への装着方法

(57)【要約】

【課題】 比較的安全な方法によって、外部リードのは んだ付け性に対する影響が少なく、また接着剤の種類に 関係なく接着強度を高めることのできる半導体装置を提 供することを課題とする。

【解決手段】 モールド樹脂によって樹脂対止されたパッケージを有する表面実装型の半導体装置において、パッケージの裏面にレーザ光を照射して、モールド樹脂表面のワックス成分を除去するようにする。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 モールド樹脂によって樹脂対止されたパッケージを有する表面実装型の半導体装置において、 前記パッケージの裏面にレーザ光を照射したことを特徴 とする半導体装置。

【請求項2】 前記パッケージ裏面に対するレーザ光の 照射により前記モールド樹脂表面のワックス成分を除去 したことを特徴とする請求項1に記載の半導体装置。

【請求項3】 前記パッケージ裏面に対するレーザ光の 照射により前記パッケージ裏面に物理的な凹凸を構成し 10 粗雑な面にしたことを特徴とする請求項1に記載の半導 体装置。

【請求項4】 前記レーザ光の照射を半導体装置表面に マーキングを行うレーザマーク手段によって行うことを 特徴とする請求項1ないし請求項3のいずれかに記載の 半導体装置。

【請求項5】 モールド樹脂によって樹脂封止されたパッケージを有する表面実装型の半導体装置の基板への装着方法において、

前記基板への装着に先だって前記半導体装置の前記パッ 20 ケージの裏面にレーザ光を照射する照射工程と、

前記パッケージ裏面のレーザ光を照射した部分に接着剤 を塗布して前記半導体装置を前記基板に仮固定する仮固 定工程と、

仮固定された前記半導体装置のリードをはんだ付けして 固定するはんだ付け工程とをこの順に有することを特徴 とする半導体装置の基板への装着方法。

【請求項6】 前記照射工程は半導体装置表面にマーキングを行うレーザマーク手段によって行われることを特徴とする請求項5に記載の半導体装置の基板への装着方 30 法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、半導体装置とその 装着方法に関し、特に表面実装型のICとその装着方法 に関する。

[0002]

【従来の技術】SOP(Small Outline Package: 2方向にリードの出たパッケージ)やQFP(Quad Flat Package: 4方向にリードの出たパッケージ)などの表面実装型の半導体パッケージをはんだ浸漬により基板表面に実装する場合、予め接着剤を用いてパッケージを基板に接着固定させて位置決めし、その後はんだ浸漬を行うようにしている。しかし、パッケージを構成するモールド樹脂と接着剤の接着強度が低いと、はんだ浸漬までの間あるいははんだ浸漬中にパッケージが基板から脱落してしまうというトラブルが発生する。

離型材 (パッケージ成形用のモールド金型からのパッケージの離型性を向上するために用いられるワックス成分) が接着剤と樹脂との密着性を阻害すること、高温の

雰囲気で接着剤の接着強度が通常の10%~20%までに顕著に低下することなどが原因である。

【0004】これを防ぐためのパッケージと基板の接着 強度の向上の方法としては、パッケージ裏面への水素バーニングの方法があった。この方法は接着剤を塗布する 前に接着面であるパッケージ裏面を、アルコールを電気 分解して水素を発生させる水素発生器からの水素の炎で いったん焼いて、離型材を除去する方法である。

【0005】しかし、この方法は次のような点で問題があった。

- 1) 水素の炎を扱うため、取扱いに留意しないと火災や火傷の危険がある。
- 2) パッケージが短時間であるが高熱にさらされるため、外部リードのはんだ付け性が低下する可能性がある。
- 3) 水素バーニングによる接着強度の向上は飛躍的なものがあるが、経時変化によって強度はどんどん劣化し、 長時間放置するとかえって未処理のものよりも低下する ことがある。

[0006]

【発明が解決しようとする課題】上述のごとく、従来の表面実装型の半導体装置の基板への装着の際に、接着剤を塗布するパッケージ裏面をいったん水素の炎で焼いて、離型材であるワックス成分を除去する等の方法を採っているが、水素の炎を扱うために危険が大きく、外部リードのはんだ付け性が低下する虞があり、しかも接着強度の向上の効果が短時間で消滅するなどの問題があった。

【0007】本発明はこの点を解決して、比較的安全な方法によって、外部リードのはんだ付け性に対する影響が少なく、また接着剤の種類に関係なく接着強度を高めることのできる半導体装置とその半導体装置の装着方法を提供することを課題とする。

[0008]

【従来の技術】SOP(Small Outline 【課題を解決するための手段】上記目的を達成するた Package: 2方向にリードの出たパッケージ)や QFP(Quad Flat Package: 4方向 40 ッケージを有する表面実装型の半導体装置において、前 にリードの出たパッケージ)などの表面実装型の半導体 パッケージをはんが浸漬により基板表面に実装する場

【0009】また、モールド樹脂によって樹脂封止されたパッケージを有する表面実装型の半導体装置の基板への装着方法において、前記基板への装着に先だって前記半導体装置の前記パッケージの裏面にレーザ光を照射する照射工程と、前記パッケージ裏面のレーザ光を照射した部分に接着剤を塗布して前記半導体装置を前記基板に仮固定する仮固定工程と、仮固定された前記半導体装置のリードをはんだ付けして固定するはんだ付け工程とを

20

この順に有することを特徴とする。 [0010]

【発明の実施の形態】以下、本発明にかかる半導体装置 および半導体装置の装着方法を添付図面を参照にして詳 細に説明する。本発明では、半導体装置の基板への装着 に先だって半導体装置パッケージの裏面をレーザ光によ ってバーニングする方法を採用する。このバーニング用 のレーザ光を発生する装置には、従来半導体パッケージ マーキングに用いられている設備をそのまま使用するよ うにしている。

【0011】本発明の説明に入る前に、従来の半導体バ ッケージマーキング装置について説明する。 図1は、従 来の半導体パッケージマーキング装置の構成を示すブロ ック図である。図1に示したように装置はレーザヘッド 1と加工ヘッド2と制御装置3から構成されている。

【0012】レーザヘッド1は、Nd3+YAGレーザの ロッド11と、これを励起するクリプトンアークランプ やキセノンフラッシュランプなどの励起ランプ12と、 Qスイッチ13と、反射ミラー14と、出力ミラー15 およびレーザ出力レンズ16などから構成される。

【0013】加工ヘッド2は、レーザ入力レンズ21 と、X軸スキャナミラー22と、Y軸スキャナミラー2 3と、スキャナミラー22、23をそれぞれ駆動するガ ルバノメータ24、25と、f θレンズ26などから構 成されている。

【0014】また、制御装置3は、レーザ加工用のパラ メータを入力するパーソナルコンピュータ31と、パー ソナルコンピュータ31に入力されたパラメータに従っ て、加工ヘッド2のスキャナミラー22、23を駆動さ せてレーザ光を目的どうり移動するようにするガルバノ 30 メータ駆動制御回路32などから構成されている。

【0015】レーザマーカはマーキングの方法によって 3通りに区別される。図2に示すスキャン型レーザマー カは、CW発援やQスイッチパルス発振のYAGレーザ 光をガルバノメータ24、25で走査すると共に、 $f\theta$ レンズ26で集光することによって、一筆書き式に文字 等をスキャンして書く方法を用いている。この時、レー ザ光を f θレンズ26で直接集光する方法と、レーザ光 をいったんアパチャマスクを通した後、f θレンズ26 で集光する方法がある。前者は加工断面が狭く深くな り、視認性でやや劣る。後者は加工断面が広く浅くな り、視認性はよい。

【0016】また、図3に示すマスク型レーザマーカ は、ノーマルパルス発振のYAGレーザ光を固定ガラス マスク28や液晶マスク上のパターンに照射し、ワーク 上にマスクに描かれた文字や図形を結像レンズ29で結 像して一括転写、焼き付けする方式である。

【0017】また、図4に示すスキャン+マスク型は、 以上の二つの形式を組み合わせた方式で、フォント選択 用のスキャナミラー22a、23aをガルバノメータ2 50 射パターンの例である。この実施の形態では、上述の半

4a、25aで駆動してフォントマスク28に記された 文字を選択してワーク上に転写するので、マスクに汎用 性を持たすことができる。本発明の実施の形態では、こ のような図1~図4に示された半導体パッケージマーキ ング装置をそのまま用いる。

【0018】ところで図5は、脱落トラブルが発生した 表面実装型のICサンプル5個についての、 パッケージ の表面と裏面の基板接着強度の実測値の最大値と最小値 および平均値を示したものである。ここでパッケージ表 面はレーザマーカによるマークが刻印されており、裏面 は水素バーニングが行われている。

【0019】この実測例から、明らかなように、表面の 基板接着強度は裏面の接着強度に比べて遥かに高い値を 示している。このように表面側の接着強度が裏面側より も高いのは、マークが刻印されていることによって、接 着剤とパッケージが十分接触するようになって、いわゆ るぬれ性が高まっているためであると考えられる。この ような観点から、本発明はパッケージマーキング装置を 利用して裏面にもレーザ光を当てマークに類する刻印を 刻み、ぬれ性を高めることを考えている。 さらにレーザ 光を当てると、水素バーニングを行わなくてもワックス 成分を除去することができると考えられ、より効率的で ある。

【0020】図6は本発明の第1の実施の形態のパッケ ージ裏面の断面の概念図であり、図7はこの実施の形態 でのSOP型のパッケージの裏面から見たレーザ光の照 射パターンの例である。この実施の形態では、上述の半 導体パッケージマーキング装置を用いてパッケージ裏面 全体に均一にレーザ光を照射し、モールド金型からのパ ッケージの離型性を向上するために用いられるワックス 成分を焼失除去するようにしている。この際、パッケー ジ裏面が多少、掘り込まれてざらつきが生まれるようで あると、接着強度が増す傾向にあたるのでより好まし

【0021】この方法によると、接着剤のパッケージに 対するぬれ性が良くなり接着強度が向上するため、半導 体装置が工程途中で脱落する問題を回避することができ る。しかも、接着剤の種類にかかわらず、接着強度を向 上することができる。また、水素バーニングと異なって 40 炎を扱うことがなく、走査制御がパソコン制御により自 動的に行われるため、操作者が火傷を負ったり、火災が 発生する等の危険はまったくなくなる。また、パッケー ジ裏面のみにレーザ光を照射することができるので、水 素バーニングの場合のようにパッケージが高熱にさらさ れる虞がなく、外部リードが熱によるダメージを受けて はんだ付け性が低下する心配もない。

【0022】図8は本発明の第2の実施の形態のパッケ ージ裏面の断面の概念図であり、図9はこの実施の形態 でのSOP型のバッケージの裏面から見たレーザ光の照 導体パッケージマーキング装置を用いてパッケージ裏面を10~20μm掘り込んで凹凸を作り出すことで機械的な接着強度を向上させる。図9では、この掘り込みを規則的な格子状の位置に設けているが、必ずしも規則的な配置に設けられる必要はなく、ランダムな配置であっても差支えない。

【0023】この方法によると、接着剤のパッケージに対するぬれ性が良くなり接着強度が向上するため、半導体装置が工程途中で脱落する問題を回避することができる。しかも、接着剤の種類にかかわらず、接着強度を向10上することが可能である。また、水素パーニングと異なって炎を扱うことがなく、走査制御がパソコン制御により自動的に行われるため、操作者が火傷を負ったり、火災が発生する等の危険はまったくなくなる。また、パッケージ裏面のみにレーザ光を照射することができるので、水素パーニングの場合のようにパッケージが高熱にさらされる虞がなく、外部リードが熱によるダメージを受けてはんだ付け性が低下する心配もない。さらに図6および図7に示した実施の形態に比べ、レーザ光の照射面積が狭くてすむので、握り込みの深さがより深くても20作業時間はより少なくてすみ、一層効率的である。

[0024]

【発明の効果】以上説明したように本発明の請求項1の 発明は、モールド樹脂によって樹脂封止されたパッケー ジを有する表面実装型の半導体装置において、パッケー ジの裏面にレーザ光を照射するようにした。

【0025】さらに本発明の請求項2の発明は、バッケージ裏面に対するレーザ光の照射によりモールド樹脂表面のワックス成分を除去するようにする。

【0026】さらに本発明の請求項3の発明は、バッケ 30 ージ裏面に対するレーザ光の照射によりバッケージ裏面に物理的な凹凸を構成し粗雑な面にする。これにより、接着剤のバッケージに対するぬれ性が良くなり接着強度が向上するため、半導体装置が工程途中で脱落する問題を回避することができる。しかも、接着剤の種類にかかわらず、接着強度を向上することができるし、水素バーニングと異なって炎を扱うことがないので、操作者が火傷を負ったり、火災がおきる等の危険はまったくなくなる。また、バッケージ裏面のみにレーザ光を照射することができるので、水素バーニングの場合のようにバッケ 40 ージが高熱にさらされるおそれがなく、外部リードが熱によるダメージを受けてはんだ付け性が低下する心配もない。

【0027】さらに本発明の請求項4の発明は、このようなレーザ光の照射を半導体装置表面にマーキングを行うレーザマーク手段によって行うようにする。したがって、パッケージの裏面にレーザ光を照射するための装置を新たに設ける必要はなく、従来の設備を用いて実行できるので経済的であり、また、レーザ光の走査制御をパソコン制御により自動的に行うことができるので、安全50

で生産性が高い。

【0028】本発明の請求項5の発明は、モールド樹脂 によって樹脂封止されたパッケージを有する表面実装型 の半導体装置の基板への装着方法において、基板への装 着に先だって半導体装置のパッケージの裏面にレーザ光 を照射する照射工程と、パッケージ裏面のレーザ光を照 射した部分に接着剤を塗布して半導体装置を基板に仮固 定する仮固定工程と、仮固定された半導体装置のリード をはんだ付けして固定するはんだ付け工程とをこの順に 有することを特徴とする。これによって、接着剤の接着 強度を高めて半導体装置の基板へ仮固定できるので、半 導体装置が工程途中で脱落する問題を回避することが可 能な半導体装置の基板への装着方法が実現できる。しか も、接着剤の種類にかかわらず、接着強度を向上するこ とができ、炎を扱うことがないので、操作者が火傷を負 ったり、火災がおきる等の危険はまったくなく、水素バ ーニングの場合のようにパッケージが高熱にさらされる 虞がないので、外部リードが熱によるダメージを受けて はんだ付け性が低下する心配がない装着方法が得られ ۵.

6

【0029】本発明の請求項6の発明は、照射工程を半 導体装置表面にマーキングを行うレーザマーク手段によって行うようにする。したがって、パッケージの裏面に レーザ光を照射するための装置を新たに設ける必要はな く、従来の設備を用いて実行できるので経済的で、レー ザ光の走査制御をパソコン制御により自動的に行うこと ができるので、安全で生産性が高い半導体装置の基板へ の装着方法が実現できる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明に用いられる半導体パッケージマーキング装置の構成を示すブロック図である。

【図2】スキャン型レーザマーカの光学系を示す構成図 である。

【図3】マスク型レーザマーカの光学系を示す構成図で ***

【図4】スキャン+マスク型レーザマーカの光学系を示す構成図である。

【図5】 脱落トラブルが発生した表面実装型の I C サンプルについての基板接着強度の実測値である。

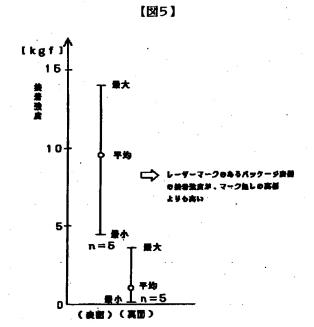
【図6】本発明の第1の実施の形態のパッケージ裏面の 断面の概念図である。

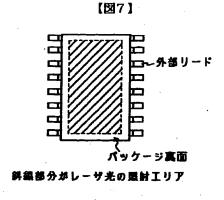
【図7】図6に示す実施の形態でのSOP型のパッケージの裏面から見たレーザ光の照射パターンの説明図である。

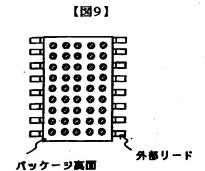
【図8】本発明の第2の実施の形態のバッケージ裏面の 断面の概念図である。

【図9】図8に示す実施の形態でのSOP型のバッケージの裏面から見たレーザ光の照射パターンの説明図である。

0 【符号の説明】







斜線部分がレーザ光の風射エリア